PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

20022356489

(43)Date of publication of application: 13.12.2002

(51)Int.Cl.

CO7D519/00 CO7D487/04 CO7F 15/00 CO8K 5/00 C08L101/00 CO9K 11/06 H05B 33/14 H05B 33/22

(21)Application number: 2001-322489

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

19.10.2001

(72)Inventor:

KIMURA KEIZO

(30)Priority

Priority number : 2001090185

Priority date: 27.03.2001

Priority country: JP

(54) NEW HETEROCYCLIC COMPOUND AND LUMINOUS ELEMENT USING THE SAME

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a material for luminous elements having good luminous characteristics and excellent stability during repeated use.

SOLUTION: This material for the luminous elements is characterized as a compound having at least one [1,2,4]triazolo[4,3-b] pyridazine skeleton or [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine skeleton.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-356489 (P2002-356489A)

(43)公開日 平成14年12月13日(2002.12.13)

(51) Int.Cl.7	識別記号		FΙ		Ť	-73-ド(参考)
C 0 7 D 519/00	3 1 1		C 0 7 D 519/	00	3 1 1	3 K 0 0 7
487/04	145		487/	04	145	4 C 0 5 0
	146				146	4 C 0 7 2
C 0 7 F 15/00			C07F 15/	00	Α	4H050
					E	4 J 0 0 2
		審查請求	未請求 請求項の	D数5 OL	(全 46 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号	特顧2001-322489(P2001-322489)	(71)出願人	000005201
(22)出顧日	平成13年10月19日(2001.10.19)	(mo) stems de	富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願2001-90185(P2001-90185) 平成13年3月27日(2001.3,27)	(72)発明者	木村 桂三 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人	100105647 弁理士 小栗 昌平 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規ヘテロ環化合物、およびそれを使用した発光素子

(57)【要約】

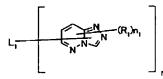
【課題】発光特性が良好であり、また繰り返し使用時での安定性に優れた発光素子用材料を提供する。 【解決手段】少なくとも1つの[1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ビリダジン骨格または[1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-a]ビリミジン骨格を有する化合物であることを特徴とする発光素子用材料。 1.

【特許請求の範囲】

【請求項1】一対の電極間に発光層もしくは発光層を含 む複数の有機化合物層を形成した発光素子において、下 記一般式(Ⅰ)または(Ⅱ)で表される化合物を有機化 合物層の少なくとも1層に少なくとも1種含有すること を特徴とする発光素子。

【化1】

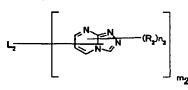
--般式(I)



(一般式(I)において、R,は置換基を表し、L,は連 結基を表す。n,は0~4の整数を表し、m,は2以上の* *整数を表す。)

【化2】

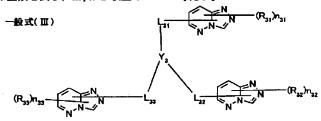
一般式(Ⅱ)



10 (一般式(II)において、R,は置換基を表し、L,は連 結基を表す。n,は0~4の整数を表し、m,は2以上の 整数を表す。)

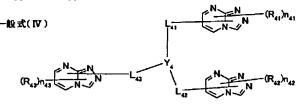
【請求項2】下記一般式(III)または(IV)で表され る化合物。

[化3]



(一般式(III)において、R,1、R,2およびR,1はそ れぞれ置換基を表し、n,1、n,2 およびn,1はそれぞれ 0~4の整数を表す。 L,1、L,1 およびL,1 はそれぞれ※ ※連結基を表す。Y,は窒素原子またはベンゼントリイル 基を表す。)

【化4】



(一般式(IV) において、R.,、R.,およびR.,はそれ ぞれ置換基を表し、 n 41、 n 42 および n 43 はそれぞれ 0 ~4の整数を表す。し、1、し、1およびし、1はそれぞれ連 結基を表す。Y、は窒素原子またはベンゼントリイル基 を表す。)

【請求項3】一対の電極間に発光層もしくは発光層を含 求項2に記載の一般式(III)または(IV)で表される 化合物を有機化合物層の少なくとも1層に少なくとも1 種含有することを特徴とする発光素子。

【請求項4】一対の電極間に発光層もしくは発光層を含 む複数の有機化合物層を形成した発光素子において、少 なくとも一層が請求項1および2記載の一般式(1)~ (IV) で表される化合物の少なくとも一種をポリマーに 分散した層であることを特徴とする発光素子。

【請求項5】一対の電極間に発光層もしくは発光層を含 む複数の有機化合物層を形成した発光素子において、請 50 示素子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸

求項1および2記載の一般式(I)~(IV)で表される 化合物の少なくとも一種を含有する層に遷移金属錯体を 含有することを特徴とする発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規へテロ環化合 む複数の有機化合物層を形成した発光素子において、請 40 物に関する。詳しくは電気エネルギーを光に変換して発 光できる発光素子用材料および発光素子に関し、表示素 子、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明光 源、記録光源、読み取り光源、標識、看板、インテリ ア、光通信デバイス等の分野に好適に使用できる発光素 子に関する。

[0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が活発であり、中でも有機電界発光(EL)素子は、低 電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表

着により有機薄膜を形成する発光素子が知られている (アプライド フィジックス レターズ, 51巻, 91 3頁、1987年)。この文献に記載された発光素子は トリス(8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウム錯体 (Alq)を電子輸送材料として用い、正孔輸送材料 (アミン化合物)と積層させることにより、従来の単層 型素子に比べて発光特性を大幅に向上させている。

【0003】上記積層型発光素子の発光効率を更に改良 する手段として、蛍光色素をドープする方法が知られて いる。例えば、ジャーナル オブ アプライド フィジ 10 ックス 65巻、3610頁、1989年に記載のクマ リン色素をドープした発光素子はドープしない素子に比 べて発光効率が大幅に向上している。この場合、用いる 蛍光性化合物の種類を変えることにより所望の波長の光 を取り出すことが可能であるが、電子輸送材料としてA 1 q を用いた場合、高輝度を得るために駆動電圧を高く すると、ドープした蛍光性化合物の発光の他にAlaの 緑色発光が観測されてくるため、青色を発光させる場合 には色純度の低下が問題になり、色純度を低下させない として特開平10-92578号、米国特許第5766 779号に特定のインドール誘導体が開示されている が、記載の化合物では高輝度発光のためには駆動電圧を 高くする必要があるなどの問題があり、低電圧で高輝度 発光可能な化合物の開発が望まれていた。また、発光効 率を高める方法として3-(4-ビフェニルイル)-4 -7x=10-5-(4-tert-7)1. 2. 4 - トリアゾール (TAZ)、バソクプロイン (BCP) などのホールブロック性材料を用いる方法が 報告されているが、これら公知の材料では耐久性、特に 30 髙温保存経時、連続発光での素子劣化が大きな問題とな っていた。また、色純度が良好で発光効率が高い従来の 素子は電荷輸送材料中に蛍光性色素を微量ドープしたも のであり、製造上素子特性の再現性を出すことが難しい ことや、色素の耐久性が低いために長時間使用した場合 に輝度の低下、色変化が起きるなどの問題があった。と れを解決する手段として電荷輸送機能と発光機能を兼ね た材料の開発が望まれているが、これまで開発された材 料では蛍光性色素を髙濃度で用いると、濃度消光、会合 等により高輝度発光が難しいといった問題があった。

【0004】一方、有機発光素子において高輝度発光を 実現しているものは有機物質を真空蒸着によって積層し ている素子であるが、製造工程の簡略化、加工性、大面 積化等の観点から塗布方式による素子作製が望ましい。 しかしながら、従来の塗布方式で作製した素子では発光 輝度、発光効率の点で蒸着方式で作製した素子に劣って おり、髙輝度、髙効率発光化が大きな課題となってい た。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の第一の目的 は、発光特性が良好であり、また繰り返し使用時での安 定性に優れた発光素子用材料および発光素子の提供にあ る。本発明の第二の目的は、色純度に優れた発光素子お よびそれを可能にする発光素子用材料の提供にある。本 発明の第三の目的は、各種電子デバイス等に有効な新規 ヘテロ環化合物を提供することにある。

[0006]

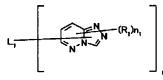
【課題を解決するための手段】との課題は下記手段によ って達成された。

- (1)一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数 の有機化合物層を形成した発光素子において、少なくと も1つの[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジ ン骨格または[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-a]ピリ ミジン骨格を有する化合物を含有することを特徴とする 発光素子。
- (2) 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数 の有機化合物層を形成した発光素子において、下記一般 ホスト材料の開発が望まれている。これを改良するもの 20 式(I)または(II)で表される化合物を有機化合物層 の少なくとも1層に少なくとも1種含有することを特徴 とする発光素子。

[0007]

【化5】

-般式(I)



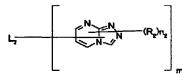
【0008】(一般式(I)において、R,は置換基を 表し、L,は連結基を表す。n,は0~4の整数を表し、 m,は2以上の整数を表す。)

[0009]

【化6】

40

─般式(Ⅱ)



【0010】(一般式(II)において、R,は置換基を 表し、L,は連結基を表す。n,は0~4の整数を表し、 m,は2以上の整数を表す。)

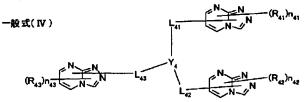
(3)下記一般式(III)または(IV)で表される化合 物。

[0011]

【化7】

【0012】(一般式(III)において、R,1、R,1 お よびR,,はそれぞれ置換基を表し、n,,、n,,およびn 10 【0013】 "はそれぞれ0~4の整数を表す。L,1、L,2およびL ,,はそれぞれ連結基を表す。Y,は窒素原子またはベン *

*ゼントリイル基を表す。) [化8]



びR.,はそれぞれ置換基を表し、n.,、n.,およびn., はそれぞれ0~4の整数を表す。L,,、L,,およびL,, はそれぞれ連結基を表す。Y、は窒素原子またはベンゼ ントリイル基を表す。)

(4)一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数 の有機化合物層を形成した発光素子において、(3)に 記載の一般式(III)または(IV)で表される化合物を 有機化合物層の少なくとも1層に少なくとも1種含有す ることを特徴とする発光素子。

(5)一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数 30 の有機化合物層を形成した発光素子において、少なくと も一層が(2) および(3) 記載の一般式(I)~(I v) で表される化合物の少なくとも一種を含有する層で あることを特徴とする発光素子。

【0015】(6)一対の電極間に発光層もしくは発光 層を含む複数の有機化合物層を形成した発光素子におい て、少なくとも一層が(2)および(3)記載の一般式 (I)~(IV)で表される化合物の少なくとも一種をポ リマーに分散した層であることを特徴とする上記(5) 記載の発光素子。

【0016】(7)一対の電極間に発光層もしくは発光 層を含む複数の有機化合物層を形成した発光素子におい て、(2) および(3) 記載の一般式(I)~(IV) で 表される化合物の少なくとも一種を含有する層に遷移金 属錯体を含有することを特徴とする上記(5)または (6)記載の発光素子。

[0017]

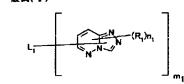
【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明

【0018】少なくとも1つの[1, 2, 4]トリアゾロ 50

【0014】(一般式(IV)において、R.,、R.,およ 20 [4,3-b]ピリダジン骨格または[1,2,4]トリア ゾロ[4, 3-a]ピリミジン骨格を有する化合物として 好ましくは分子内に更にアゾール骨格を有するものであ る。この場合のアゾール骨格としては単環または縮環の いずれでもよく、例えばイミダゾール、ベンズイミダゾ ール、ナフトイミダゾール、チアゾール、ベンズチアゾ ール、ナフトチアゾール、イソチアゾール、オキサゾー ル、ベンズオキサゾール、ナフトオキサゾール、イソオ キサゾール、セレナゾール、ベンズセレナゾール、ナフ トセレナゾール、ピラゾール、インダゾール、トリアゾ ール、ベンゾトリアゾール、4-アザベンズイミダザー ル、プリンおよびテトラザインデンなどが挙げられる。 アゾール骨格としてより好ましくは、イミダゾール、ベ ンズイミダゾール、ナフトイミダゾール、ベンズチアゾ ール、オキサゾール、ベンズオキサゾール、イソオキサ ゾール、インダゾール、ベンゾトリアゾール、4-アザ ベンズイミダザール、プリンおよびテトラザインデンで あり、更に好ましくはベンズイミダゾール、ベンズオキ サゾール、インダゾール、4-アザベンズイミダザー ル、プリンおよびテトラザインデンであり、最も好まし 40 くは[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンま たは[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-a]ピリミジンで ある。

> 【0019】本発明の[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3 -b]ビリダジン骨格または[1,2,4]トリアゾロ [4, 3-a]ピリミジン骨格を有する化合物としてより 好ましくは、下記一般式(I)または(II)で表される 化合物である。

[0020] 【化9】



【0021】一般式(I)において、R1は置換基を表 し、置換基としては例えばアルキル基(好ましくは炭素 しくは炭素数1~10であり、例えばメチル、エチル、 iso-プロピル、tert-ブチル、n-オクチル、 n-デシル、n-ヘキサデシル、シクロプロピル、シク ロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げられる。)、ア ルケニル基(好ましくは炭素数2~30、より好ましく は炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であ り、例えばビニル、アリル、2-ブテニル、3-ペンテ ニルなどが挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは 炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に 好ましくは炭素数2~10であり、例えばプロパルギ ル、3-ペンチニルなどが挙げられる。)、アリール基 (好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6 ~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えば フェニル、pーメチルフェニル、ナフチルなどが挙げら れる。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~30、より 好ましくは炭素数0~20、特に好ましくは炭素数0~ 10であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルア ミノ、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノ、ジフェニル アミノ、ジトリルアミノなどが挙げられる。)、アルコ 素数1~20、特に好ましくは炭素数1~10であり、 例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2-エチルヘキ シロキシなどが挙げられる。)、アリールオキシ基(好 ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~2 0、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェ ニルオキシ、1-ナフチルオキシ、2-ナフチルオキシ などが挙げられる。)、アシル基(好ましくは炭素数1 ~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましく は炭素数2~12であり、例えばアセチル、ベンゾイ ル、ホルミル、ピバロイルなどが挙げられる。)、アル 50 ドなどが挙げられる。)、リン酸アミド基(好ましくは

コキシカルボニル基(好ましくは炭素数2~30、より 好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~ 12であり、例えばメトキシカルボニル、エトキシカル ボニルなどが挙げられる。)、アリールオキシカルボニ ル基(好ましくは炭素数7~30、より好ましくは炭素 数7~20、特に好ましくは炭素数7~12であり、例 えばフェニルオキシカルボニルなどが挙げられる。)、 アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~30、より好ま しくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10 10 であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙 げられる。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~ 30、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは 炭素数2~10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾ イルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニ ルアミノ基(好ましくは炭素数2~30、より好ましく は炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~12であ り、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられ る。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましく は炭素数7~30、より好ましくは炭素数7~20、特 数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ま 20 に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェニルオ キシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、スルホニ ルアミノ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数 1~20、特に好ましくは炭素数 1~12であ り、例えばメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニ ルアミノなどが挙げられる。)、スルファモイル基(好 ましくは炭素数0~30、より好ましくは炭素数0~2 0、特に好ましくは炭素数0~12であり、例えばスル ファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファ モイル、フェニルスルファモイルなどが挙げられ 30 る。)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数 1~12であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモ イル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルな どが挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素 数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ま しくは炭素数1~12であり、例えばメチルチオ、エチ ルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ基(好まし くは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、 特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル キシ基(好ましくは炭素数 $1 \sim 3.0$ 、より好ましくは炭 40 チオなどが挙げられる。)、スルホニル基(好ましくは 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に 好ましくは炭素数1~12であり、例えばメシル、トシ ルなどが挙げられる。)、スルフィニル基(好ましくは 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に

好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルフ

ィニル、ベンゼンスルフィニルなどが挙げられる。)、

ウレイド基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく

は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ

り、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニルウレイ

炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に 好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエチルリン 酸アミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げられ る。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子 (例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原 子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ 基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、 イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは炭素数1~30、よ り好ましくは炭素数1~12であり、ヘテロ原子として は、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子、具体的には 10 であり、更に好ましくはアルキル基、アリール基、アル 例えばイミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、チ エニル、ピペリジル、モルホリノ、ベンズオキサゾリ ル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリル、カルバゾ リル、アゼピニルなどが挙げられる。)、ヘテロ環オキ シ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素 数1~12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原 子、酸素原子、硫黄原子、具体的には例えば3-イミダ ゾリルオキシ、4-ピリジルオキシ、8-キノリルオキ シ、6-ベンズオキサゾリルオキシ、5-ベンズチアゾ ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~1 2であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素 原子、硫黄原子、具体的には例えば3-イミダゾリルチ オ、4-ピリジルチオ、8-キノリルチオ、6-ベンズ オキサゾリルチオ、5-ベンズチアゾリルチオなどが挙 げられる。)、シリル基(好ましくは炭素数3~40、 より好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは炭素数 3~24であり、例えばトリメチルシリル、トリフェニ ルシリルなどが挙げられる。)などが挙げられる。これ らの置換基は更に置換されてもよい。また置換基が二つ 30 以上ある場合は、同じでも異なってもよい。また、可能 な場合には連結して環を形成してもよい。

【0022】R、として好ましくは、アルキル基、アル ケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アル コキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカ ルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキ シ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ 基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルア ミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキル チオ基、アリールチオ基、スルホニル基、ハロゲン原 子、シアノ基、ヘテロ環基であり、より好ましくはアル キル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、ア リールオキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環基 コキシ基、アリールオキシ基、芳香族へテロ環基であ り、特に好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキ シ基、芳香族へテロ環基であり、最も好ましくはアルキ

【0023】L1は連結基を表し、その連結する位置は 母核のR,が置換する位置のいずれかであり、この場合 R₁はL₁と同義である。L₁で表される連結基として好 ましくは、単結合、C、N、O、S、Si、Geなどで 形成される連結基であり、より好ましくは単結合、アル リルオキシなどが挙げられる。)、ヘテロ環チオ基(好 20 キレン、アルケニレン、アルキニレン、アリーレン、二 価以上のヘテロ環(好ましくは芳香族ヘテロ環であり、 より好ましくはアゾール、チオフェン、フラン環から形 成される芳香族へテロ環などである。)、ベンゼンート リイルおよびN、O、Sとこれらの組合わせから成る基 であり、更に好ましくはアルキレン、アリーレン、二価 以上の芳香族へテロ環、ベンゼン-トリイルおよびN、 O、Sとこれらの組合わせから成る基であり、最も好ま しくはアルキレン、ベンゼントリイルおよび〇とこれら の組み合わせから成る基である。

ル基、アルコキシ基である。

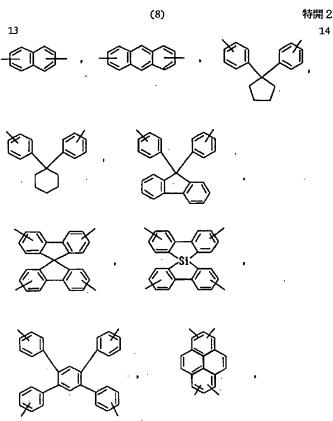
【0024】L、で表される連結基の具体例としては、 単結合の他、例えば以下のものが挙げられる。

[0025]

【化10】

$$(\zeta_s)$$
. (ζ_s)

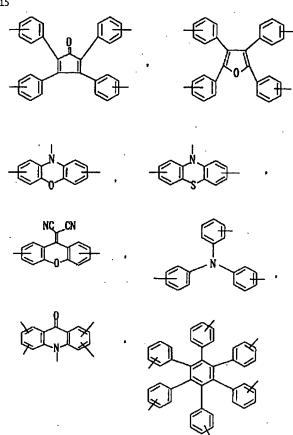
[0026] [化11]



[0027]

【化12】

15



[0028]

【化13】

【化14】

[0029]

[0030]

【化15】

[0031]

【0032】L、で表される連結基は置換基を有しても よく、置換基としては例えばR、として挙げたものが適 用できる。L₁の置換基として好ましくはアルキル基、 アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルコキシ 40 し、置換基は一般式(Ⅰ)におけるR,と同義であり、 基、アリールオキシ基、アシル基、ハロゲン原子、シア ノ基、ヘテロ環基、シリル基であり、より好ましくはア ルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、 アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、シア ノ基、芳香族へテロ環基であり、更に好ましくはアルキ ル基、アリール基、芳香族へテロ環基である。

21

【0033】n1は0~4の整数を表し、好ましくは0 ~2であり、更に好ましくは0である。

【0034】m1は2以上の整数を表し、好ましくは2

あり、特に好ましくは2または3であり、最も好ましく は3である。

【0035】一般式(II)においてR,は置換基を表 好ましい範囲も同様である。Lzは連結基を表し、連結 基は一般式(Ⅰ)におけるし、と同義であり、好ましい 範囲も同様である。

【0036】n,は0~4の整数を表し、好ましくは0 ~2であり、更に好ましくは0である。

【0037】m,は2以上の整数を表し、好ましくは2 ~8、より好ましくは2~6、更に好ましくは2~4で あり、特に好ましくは2または3であり、最も好ましく は3である。

~8、より好ましくは2~6、更に好ましくは2~4で 50 【0038】一般式(I)で表される化合物のうち、好

ましくは一般式(III)で表される化合物である。一般式(III)においてR,、、R,、およびR,,はそれぞれ一般式(I)におけるR,と同義であり、好ましい範囲も同様である。またL,、、L,、およびL,,はそれぞれ一般式(I)におけるL,と同義である。またn,、、n,、はそれぞれ一般式(I)におけるn,と同義であり、好ましい範囲も同様である。

23

【0039】L,1、L,1およびL,1として好ましくは単 結合、アルキレン、アリーレン、二価の芳香族へテロ 環、N、O、およびこれらの組み合わせからなる連結基 10 であり、より好ましくは単結合、メチレン、エチレン、 (ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、ピリジン、ピ ラジン、チオフェン、フラン、オキサゾール、チアゾー ル、オキサジアゾール、チアジアゾール、トリアゾー ル)の2箇所の水素原子を除いて結合手を付与した基、 Oまたはこれらの組み合わせからなる連結基であり、更 に好ましくは単結合、メチレン、ベンゼン、チオフェ ン、〇およびこれらの組み合わせからなる連結基であ り、特に好ましくは単結合、メチレン、ベンゼン、〇お よびこれらの組み合わせからなる連結基であり、最も好 20 ましくは単結合、メチレン、Oおよびこれらの組み合わ せからなる連結基である。し、、、し、、およびし、」は置換 基を有していてもよく、置換基としては一般式(1)に おけるR、で表される置換基として挙げたものと同義で ある。

【0040】Y,は窒素原子またはベンゼントリイル基を表すが、後者はL,,、L,,およびL,,と結合する位置以外で置換基を有していてもよく、置換基としては例えばアルキル基、アリール基またはハロゲン原子などが挙げられる。Y,として好ましくは窒素原子、無置換1,3,5-ベンゼントリイル基および無置換1,2,4-ベンゼントリイル基であり、より好ましくは無置換1,3,5-ベンゼントリイル基であり、最も好ましくは無置換1,3,5-ベンゼントリイル基である。

【0041】一般式(III)で表される化合物のうち、 更に好ましくは一般式(V)、一般式(VI)および(X 1)で表される化合物である。

[0042]

【化17】

一般式(V)

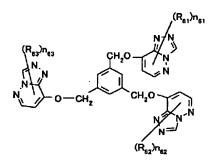
(13)

【0043】一般式(V)において R_{11} 、 R_{12} はよび R_{13} はそれぞれ置換基を表し、置換基は一般式(I)における R_{14} と同義であり、好ましい範囲も同様である。 R_{11} 、 R_{12} はよび R_{13} は0~4の整数を表し、好ましくは0~2であり、更に好ましくは0である。ベンゼン環に対する酸素原子の結合位置は1、2、3または1、2、4または1、3、5が更に好ましく、1、2、4または1、3、5が更に好ましく、1、3、5が最も好ましい。【0044】

【化18】

一般式(VI)

30



【0045】一般式(VI)においてR₆₁、R₆₂およびR 40 ₆,はそれぞれ置換基を表し、置換基は一般式(I)におけるR₁と同義であり、好ましい範囲も同様である。 n 61、 n₆₂および n₆,は0~4の整数を表し、好ましくは 0~2であり、更に好ましくは0である。

[0046]

【化19】

【0047】一般式(XI)において、R111、R111お よびR111はそれぞれ置換基を表し、置換基は一般式 (1) におけるR、と同義であり、好ましい範囲も同様 である。 n111、 n112 および n111は 0~3 の整数を表 し、好ましくは0~2であり、更に好ましくは0~1で あり、最も好ましくは0である。ベンゼン環に対する酸 素原子の結合位置は1,2,3または1,2,4または 1, 3, 5が好ましく、1, 2, 4または1, 3, 5が 更に好ましく、1、3、5が最も好ましい。

【0048】一般式(II)で表される化合物のうち、好米 一般式(VII)

*ましくは一般式(IV)で表される化合物である。一般式 (IV) においてR.,、R.,およびR.,はそれぞれ一般式 (II) におけるR₂と同義であり、好ましい範囲も同様 である。 Lax Lax およびLayはそれぞれ一般式(II I) におけるL,1、L,2およびL,1と同義であり、好ま しい範囲も同様である。またn.1、n.2、n.3はそれぞ れ一般式(II)におけるnzと同義であり、好ましい範 囲も同様である。また、Y、は一般式(III)におけるY 」と同義であり、好ましくは、窒素原子、無置換 1,

10 3,5-ベンゼントリイル基および無置換1,2,4-ベンゼントリイル基であり、最も好ましくは無置換1, 3,5-ベンゼントリイル基である。

【0049】一般式(IV)で表される化合物のうち、更 に好ましくは一般式 (VII) および一般式 (VIII) で表 される化合物である。

[0050] 【化20】

$$(R_{71})n_{71}$$
 $(R_{72})n_{72}$ $(R_{72})n_{72}$ $(R_{72})n_{72}$ $(R_{72})n_{72}$ $(R_{72})n_{72}$ $(R_{72})n_{73}$ $(R$

【0051】一般式 (VII) においてR,1、R,2および R,」はそれぞれ置換基を表し、置換基は一般式(I)に おけるR、と同義であり、好ましい範囲も同様である。

n,1、n,2 およびn,3は0~4の整数を表し、好ましく※

[0052] 【化21】

一般式(VD)

【0053】一般式 (VIII) においてR。1、R。2 および R.,はそれぞれ置換基を表し、置換基は一般式(I)に おけるR1と同義であり、好ましい範囲も同様である。 n。1、n。2およびn。3は0~4の整数を表し、好ましく は0~2であり、更に好ましくは0である。 【0054】一般式(V)、(VI)、(VII)、(VII

I) および(XI) で表される化合物において、最も好 ましくは一般式(XI)で表される化合物である。 【0055】本発明の化合物(一般式(I)~(XI)) は、低分子量化合物であっても良いし、残基が2個以上 ボリマー主鎖に接続された髙分子量化合物(好ましくは 50 重量平均分子量1000~500000、特に好まし

30

28

くは5000~200000、さらに好ましくは10000~100000) もしくは、本発明の化合物を主鎖にもつ高分子量化合物(好ましくは重量平均分子量1000~500000、特に好ましくは5000~200000、更に好ましくは10000~1000000) であってもよい。高分子量化合物の場合は、ホモボリマーであっても良いし、他のモノマーとの共重合体であっても良い。本発明で用いられる化合物としては、好ましくは低分子量化合物である。また、上記の一般式では便宜的に極限構造式で表しているが、その互変10異性体であってもよい。

【0056】以下に本発明の化合物の具体例を示すが、 本発明はとれらに限定されるものではない。

[0057]

(E-3)

【化22】

【0058】 【化23】 (E-6)

[0059] [化24]

29 **(E-9)**

(E-11)

(E-12)

[0060]

(E-14)

(E-15)

[0061]

【化26】

33 (E-16)

(E-17)

(E-18)

[0062]

【化27】

[0063]

【化28】

(E-23)

[0064]

【化29】

(E-26)

(E-27)

[0065]

【化30】

41 (E-28)

[0066] [化31]

43 (E-31)

[0067]

【化32】

(E-34)

[0068]

[化33]

(E-38)

[0069]

[化34]

質量平均分子量 17000 (ポリスチレン換算)

m: n =1 : 1 (モル比)

[0070]

質量平均分子量 23000 (ポリスチレン換算)

(E-43)

質量平均分子量 2000 (ポリステレン換算)

[0071] [作36]

(E-44)

[0072] [1L37]

51

(E-45)

(E-46)

(E-47)

(E-48)

53 (E-49)

(E-50)

(E-51)

(E-52)

[0073] [(£38] (E-53)

【0074】例示化合物 (E-49)のNMRデータ (溶媒CDC1,)

8 = 8 . 8 O(s、2 H)、8 . 1 1 (d、2 H、J = 1 1 H z)、7 . 3 5 (d、4 H、J = 1 0 H z)、7 . 1 8 (d、4 H、J = 1 0 H z)、7 . 0 5 (d、2 H、J = 1 1 H z)、1 . 7 8 (s、6 H)

[0075] 例示化合物 (E – 5 0)のNMRデータ
(溶媒CDC1,)

 δ = 8. 81(s, 2H), 8. 11(d, 2H, J=11Hz), 7. 35(d, 4H, J=10Hz), 7. 19(s, 4H), 7. 12(d, 4H, J=10Hz), 7. 05(d, 2H, J=11Hz), 1. 71(s, 12H)

【0076】一般式(I)、(III)、(V)、(VI) および(XI)で表される本発明の化合物はTetra 40 hedron Letters、3193ページ(1976年)、Journal of Heterocyclic Chemistry、13巻、835ページ(1976年)、Chemische Berichte、116巻、3513ページ(1983年)、Journal of Heterocyclic Chemistry、5巻、513ページ(1968年)、薬学雑誌75巻778ページ(1955年)、同75巻1242ページ(1955年)などに記載の方法を参考にして合成できる。

50 【0077】一般式 (II)、 (IV)、 (VII) および (V

III)で表される本発明の化合物は薬学雑誌、79巻、 903ページ (1959年)、Tetrahedro n、24巻、2839ページ(1968年)などに記載 の方法を参考にして合成できる。

55

【0078】以下に本発明の化合物の合成法について具*

* 体例をもって説明する。 合成例1 例示化合物(E-15)の合成 [0079]

【化39】

【0080】・化合物(3)の合成

3ツ□フラスコに化合物(1)420.4g、化合物 (2) 565ml、p-トルエンスルホン酸-水和物5 g、トルエン31を入れ、5時間の間加熱還流下にて撹 拌しながら生成する水を分離した。その後室温まで冷却 し、吸引濾過して得られた濾液をロータリーエバポレー ターにて濃縮して、得られた残留物にイソプロビルアル コール1.51を添加して、氷冷下にて撹拌した。析出 した結晶を吸引濾過して得られた結晶を乾燥し、目的の 化合物(3)675gを得た(収率90%)。

・化合物(4)の合成

3ツ□フラスコにN, N-ジメチルアセトアミド11、 アセトニトリル11を入れ、内温を-3℃以下に保ちな がらことへオキシ塩化リン276m1を1時間かけて滴 下した。そのまま1時間撹拌し、ことへ化合物(3)1

を1時間かけて滴下した。この後内温50℃にて8時間 撹拌した後、氷5 kgに注いでことへ水酸化ナトリウム 600gと水21からなる水溶液を加え、1時間撹拌し た。さらにここへ酢酸エチル51を添加して抽出し、得 られた酢酸エチル層を飽和食塩水0.51と水21から 40 なる混合液にて4回洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて 乾燥した。このものをロータリーエバポレーターにて濃 縮して得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラ フィーにて精製して目的の化合物(4)82.3gを得 た(収率47%)。

・化合物(5)の合成

3ツ□フラスコに化合物(4)88.1gメタノール3 00mlを入れ、加熱還流下にて撹拌しながらここへホ ウ素化水素ナトリウム22.7gを添加した。添加終了 後そのまま2時間撹拌を続けた後、室温まで冷却し、ロ 48gを30分かけて添加した後、ピリジン1.071 50 ータリーエバポレーターにて濃縮した。得られた残留物

3ツ口フラスコに化合物(8)6.31g、炭酸カリウ

1、アセトニトリル200mlを入れ、加熱還流下撹拌 しながらことへ化合物(7)59.8gを20分かけて

添加した。この後加熱還流下にて8時間撹拌した後、室

温まで冷却した。このものをロータリーエバポレーター

にて濃縮して得られた残留物をシリカゲルカラムクロマ

【0081】合成例2 例示化合物(E-17)の合成

トグラフィーにて精製して目的の例示化合物(E-1

*・例示化合物(E-15)の合成

をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製して目 的の化合物(5)62.4gを得た(収率70%)。 ・化合物(7)の合成

57

3ツ□フラスコに化合物(5)53.5g、N,N-ジ メチルアセトアミド350mlを入れ内温を9℃以下に 保ちながらことへ化合物(6)62.9gを添加し、更 に続けてビリジン26.6mlを滴下した。この後室温 にて5時間撹拌した後、ことへ酢酸エチル900ml、 水800m1を添加して抽出した。得られた酢酸エチル 層を飽和食塩水100mlと水600mlの混合液にて 10 5)7.3gを得た(収率24%)。融点:250℃以 5回洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥し、ロータ リーエバポレーターにて濃縮して、得られた残留物をシ リカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製して目的の 化合物(7)85.7gを得た(収率86%)。

(E-17)

[0082]

[化40]

(11)

【0083】・化合物(11)の合成

3ツ口フラスコに化合物 (9) 12.6g、化合物 (1 0) 100m1、エチレングリコール200m1を入れ て加熱還流下にて3時間撹拌した。このものをロータリ ーエバポレーターで濃縮して得られた残留物を氷冷下に て撹拌し、析出した結晶を吸引濾過した。得られた結晶 を水10m1を用いて再結晶した後乾燥して、目的の化 合物(11)5.1gを得た(収率41%)。

·例示化合物(E-17)の合成 3ツ□フラスコに化合物(11)22.3g、炭酸カリ ウム49. 7g. N. N-ジメチルアセトアミド100%

※m1を入れて内温80℃に加熱しながら撹拌し、ここへ 30 化合物(12)17.8gとN、N-ジメチルアセトア ミド35m1からなる溶液を15分かけて滴下した。滴 下終了後そのまま5時間過熱撹拌を続けた後、室温まで 冷却し、ロータリーエバボレーターで濃縮して得られた 残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製 して、目的の例示化合物(E-17)3.4gを得た

(収率14%)。融点:250℃以上。

【0084】合成例3 例示化合物(E-53)の合成 [0085]

【化41】

【0086】3ツ口フラスコに化合物(14)12.6 50 g、カリウムー t - ブトキシド37.0g、N, N - ジ

メチルアセトアミド100mlを入れ、100℃にて加熱しながら1時間撹拌した。その後、室温まで冷却し、撹拌しなからここへ化合物(13)51.0gを添加し、室温で1時間撹拌した後、100℃にて5時間加熱撹拌した。このものを室温まで冷却した後、氷にあけ、析出した結晶を吸引濾過した。得られた結晶にアセトニトリル300mlを添加して加熱還流下にて1時間撹拌した。このものを室温まで冷却した後、吸引濾過して目的の例示化合物(E-53)37.5gを得た(収率78%)。融点:250℃以上。尚、化合物(13)は薬学雑誌75巻778ページ(1955年)および同75巻1242ページ(1955年)に従い合成した。

【0087】本発明の化合物(I)~(IV)を含有する層は、好ましくは更に遷移金属錯体を含有する。すなわち、遷移金属錯体をゲスト化合物として、本発明の化合物であるホスト化合物中にドープしてなる形態が好ましい。ことでゲスト化合物のT,レベル(最低三重項励起状態のエネルギーレベル)はホスト化合物のT,レベルよりも小さいことが好ましい。本発明における遷移金属錯体としてはりん光発光性を有する錯体が好ましい。【0088】また、発光層に隣接する層(例えばホール輸送層、電子輸送層、ホールブロック層など)に含まれる化合物のT,レベルは発光層中のゲスト化合物のT,レベルよりも大きいことが好ましく、ホスト化合物のT,レベルよりも大きいことが好ましく、ホスト化合物のT,レ

【0089】本発明において、遷移金属錯体とは、例えば「錯体化学の基礎 ウエルナー錯体と有機金属錯体」 講談社 渡部正利、矢野重信 碇屋隆雄著 1989年 発行、「有機金属化学-基礎と応用-」裳華房社 山本 明夫著 1982年発行 等に記載されている化合物群 30 の総称である。

ベルよりも大きいことが更に好ましい。

【0090】遷移金属錯体の金属の種類および価数は特に限定しない。金属錯体の配位子は金属錯体を形成し得るものであれば、特に問わない。配位子としては種々の公知の配位子があるが、例えば「Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds」 Springer-Verlag社 H.Yersin着1987年発行、「有機金属化学-基礎と応用ー」裳華房社山本明夫著1982年発行等に記載の配位子が挙げられ、例えば、ハロゲン配位子(好ましくは塩素配位子)、含窒素へテロ環配位子(例えば 402-フェニルビリジン、ビビリジル、フェナントロリンなど)、ジケトン配位子(アセチルアセトンなど)、リン配位子(トリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリメチルホスファイトなど)、イソシアニド配位子(tーブチルイソシアニドなど)および一酸化炭素配位子である。

【0091】本発明中の遷移金属錯体の配位子の種類は ン、シンノリン、ベリミジン、フェナントロリン、ピリ 1種類でも良いし、複数の種類があっても良い。また、 ール、イミダゾール、ピラゾール、オキサゾール、オニ 本発明中の遷移金属錯体の炭素数は、好ましくは5~1 サジアゾール、トリアゾール、チアジアゾール、ベンズ 00、より好ましくは10~60、さらに好ましくは1 50 イミダゾール、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾー

2~40である。

【0092】本発明中の遷移金属錯体は中性であっても良いし、イオンであってもよい。本発明中の遷移金属錯体がイオンの場合、このイオンとその電荷を中和する対イオンからなる。対イオンは特に限定されないが、例えば「有機金属化学-基礎と応用-」裳華房 山本明夫著1982年発行 などに記載の対イオンが挙げられる。

【0093】本発明中の遷移金属錯体は繰り返し単位を10 一つ有する、いわゆる低分子化合物であってもよく、また繰り返し単位を複数個有する、いわゆるオリゴマー化合物やポリマー化合物(質量平均分子量(ポリスチレン換算)は好ましくは1000~500000、より好ましくは2000~100000、更に好ましくは300~100000である)であってもよい。また、本発明中の遷移金属錯体は、錯体中に遷移金属原子を1つ有していてもよいし、また2つ以上有するいわゆる複核錯体であってもよい。また複数の金属原子を同時に含有していてもよい。

20 【0094】本発明の遷移金属錯体のうち、好ましくは オルトメタル化金属錯体であり、更に好ましくはオルト メタル化イリジウム錯体である。

【0095】次に、本発明で用いるオルトメタル化金属 錯体およびオルトメタル化イリジウム錯体について説明する。オルトメタル化金属錯体とは、例えば「有機金属化学-基礎と応用-」p150, 232 裳華房社山本明夫著1982年発行、「Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds」 p71-p77,p135-p146 Springer-Verlag社 H.Yersin著1987年発行等に記載されている化合物群の総称である。金属錯体の中心金属としては、遷移金属であればいずれのものも使用可能であるが、本発明では、中でも特にロジウム、白金、金、イリジウム、ルテニウム、パラジウム等を好ましく用いることができる。この中で特に好ましいものはイリジウムである。

【0096】オルトメタル化金属錯体の金属の価数は特に限定しないが、イリジウムを用いる場合には3価が好ましい。オルトメタル化金属錯体の配位子は、オルトメタル化錯体を形成し得る物であれば特に問わないが、例えば、アリール基置換含窒素へテロ環誘導体(アリール基の置換位置は含窒素へテロ環窒素原子の隣接炭素上であり、アリール基としては例えばフェニル基、ナフチル基、アントラセニル基、ピレニル基などが挙げられ、含窒素へテロ環としては、例えば、ピリジン、ビリミジン、ビラジン、ピリダジン、キノリン、イソキノリン、キノキサリン、フタラジン、キナゾリン、ナフチリジン、シンノリン、ベリミジン、フェナントロリン、ピロール、イミダゾール、ビラゾール、オキサゾール、オキサゾール、ベンズオキサゾール、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾー

ル、フェナントリジンなどが挙げられる)、ヘテロアリ ール基置換含窒素ヘテロ環誘導体(ヘテロアリール基の) 置換位置は含窒素へテロ環窒素原子の隣接炭素上であ り、ヘテロアリール基としては例えば前記の含窒素ヘテ 口環誘導体を含有する基、チオフェニル基、フリル基な どが挙げられる)、7、8-ベンゾキノリン誘導体、ホ スフィノアリール誘導体、ホスフィノヘテロアリール誘 導体、ホスフィノキシアリール誘導体、ホスフィノキシ ヘテロアリール誘導体、アミノメチルアリール誘導体、 アミノメチルヘテロアリール誘導体等が挙げられる。ア リール基置換含窒素芳香族へテロ環誘導体、ヘテロアリ ール基置換含窒素芳香族へテロ環誘導体、7,8-ベン ゾキノリン誘導体が好ましく、フェニルピリジン誘導 体、チオフェニルビリジン誘導体、7、8-ベンゾキノ リン誘導体がさらに好ましく、チオフェニルビリジン誘 導体、7.8-ベンゾキノリン誘導体が特に好ましい。 【0097】本発明の金属錯体化合物は、オルトメタル 化金属錯体を形成するに必要な配位子以外に、他の配位 子を有していても良い。他の配位子としては種々の公知 の配位子が有るが、例えば、「Photochemistry and Pho 20 はベンゼン、ナフタレン、チオフェンである。 tophysics of CoordinationCompounds」 Springer-Verl ao社 H.Yersin著1987年発行、「有機金属化学-基 礎と応用-」裳華房社山本明夫著1982年発行等に記 載の配位子が挙げられ、好ましくは、ハロゲン配位子 (好ましくは塩素配位子)、含窒素へテロ環配位子(例 えばビビリジル、フェナントロリンなど)、ジケトン配 位子であり、より好ましくは塩素配位子、ビビリジル配 位子である。

【0098】本発明のオルトメタル化金属錯体が有する も良い。錯体中の配位子の数は、好ましくは1~3種類 であり、特に好ましくは1,2種類であり、さらに好ま しくは1種類である。

【0099】本発明のオルトメタル化金属錯体の炭素数 は、好ましくは5~100、より好ましくは10~6 0、さらに好ましくは12~40である。

【0100】本発明のオルトメタル化金属錯体の好まし い形態は、下記一般式(K-I)で表される部分構造を 有する化合物またはその互変異性体である。

[0101]

【化42】





【0102】式中、Mは遷移金属を表す。Q₁₁は5員ま たは6員の芳香族環を形成するに必要な原子群を表す。 Q.,は5員または6員の芳香族アゾール環を形成するに 50 い。また、一般式(K-I)で表される部分構造を有す

必要な原子群を表す。Mで表される遷移金属として好ま しくは、ロジウム、白金、金、イリジウム、ルテニウ ム、パラジウムであり、より好ましくはロジウム、白 金、イリジウムであり、更に好ましくは白金、イリジウ ムであり、特に好ましくはイリジウムである。Qx1で形 成される5員または6員の芳香族環は、芳香族炭化水素 環、芳香族ヘテロ環のいずれでもよく、例えばベンゼ ン、ナフタレン、アントラセン、ピレン、ピリジン、キ ノリン、イソキノリン、ピリダジン、ピリミジン、ピラ 10 ジン、チオフェン、フラン、ピロール、ピラゾール、イ ミダゾール、チアゾール、オキサゾール、チアジアゾー ル、オキサジアゾール、トリアゾール、キノキサリン、 フタラジン、ナフチリジン、シンノリン、ペリミジン、 フェナントロリン、ベンズチアゾール、ベンズオキアゾ ール、ベンズイミダゾール、フェナントリジンなどが挙 げられ、好ましくはベンゼン、ナフタレン、ピリジン、 キノリン、イソキノリン、チオフェン、フランであり、 より好ましくはベンゼン、ナフタレン、ピリジン、キノ リン、イソキノリン、チオフェンであり、更に好ましく

【0103】Q,,で形成される5員または6員の芳香族 アゾール環としては、例えばピリジン、キノリン、イソ キノリン、ピリダジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラ ゾール、イミダゾール、チアゾール、オキサゾール、チ アジアゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、キノ キサリン、フタラジン、ナフチリジン、シンノリン、ベ リミジン、フェナントロリン、ベンズチアゾール、ベン ズオキアゾール、ベンズイミダゾール、フェナントリジ ンなどが挙げられ、好ましくはピリジン、キノリン、イ 配位子の種類は1種類でも良いし、複数の種類があって、30、ソキノリン、ピラゾール、ピリダジンであり、より好ま しくはピリジン、キノリン、イソキノリン、ピラゾール であり、更に好ましくはピリジン、キノリン、イソキノ リンである。Qk1、Qk2で形成される環は置換基を有し てもよく、置換基としては一般式(I)のR11で表され る基として挙げたものが適用でき、好ましい置換基とし てはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリー ル基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ア シル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカル ボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキ 40 シカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミ ノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバ モイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホニ ル基、ハロゲン原子、シアノ基およびヘテロ環基であ り、より好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキ シ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチ オ基、ハロゲン原子、シアノ基およびヘテロ環基であ り、更に好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキ シ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子およびシアノ基 である。また置換基同士が連結して環を形成しても良

る化合物またはその互変異性体は、化合物中に遷移金属を一つ有しても良いし、また、2つ以上有するいわゆる 複核錯体であっても良い。他の金属原子を同時に含有し ていても良い。

63

【0104】一般式(K-I)で表される部分構造を有する化合物のうち、より好ましくは下記一般式(K-II)で表される化合物またはその互変異性体である。 【0105】

[化43]

【0106】式中、R**** およびR**** はそれぞれ置換基を表す。 q***、q*** はそれぞれ0~4の整数を表す。 q***、q***が2以上の場合、複数個のR***、R**** はそれぞれ同一または互いに異なっても良い。

【0107】 R^{*11} 、 R^{*21} で表される置換基としては、例えば一般式(I)における R_1 で表される基の置換基として挙げたものが適用でき、好ましい範囲は Q_{k1} および Q_{k1} の置換基の場合と同様である。 R^{*11} 、 R^{*12} は更に置換されてもよい。また、置換基同士が結合して縮環構造を形成しても良い。

【0108】R**1、R*21としては好ましくはアルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アリール 30 オキシ基、ハロゲン原子、結合して縮環構造を形成する基が好ましく、より好ましくはアルキル基、アリール基、フッ素原子、結合して芳香族縮環構造を形成する基*

*である。 q^{21} 、 q^{22} としては0、1、2が好ましく、より好ましくは q^{21} + q^{22} =0、1、2である。

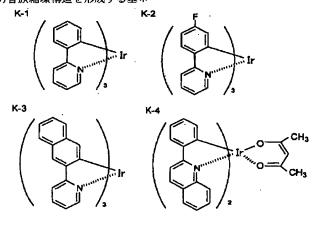
【0109】 L は は配位子を表す。配位子としては前記オルトメタル化金属錯体を形成するに必要な配位子、およびその他の配位子で説明した配位子が挙げられる。 L はオルトメタル化イリジウム錯体を形成するに必要な配位子、含窒素へテロ環配位子、ジケトン配位子、ハロゲン配位子、リン配位子、イソニトリル配位子、一酸化炭素配位子が好ましく、より好ましくはオルトメタル化10 イリジウム錯体を形成するに必要な配位子、ジケトン配位子、ビピリジル配位子、リン配位子、イソニトリル配位子、カラ

【0110】m²¹は1、2、3を表し、好ましくは2、3であり、より好ましくは3である。m²²は0~5の整数を表し、好ましくは0、1、2であり、より好ましくは0、1である。m²¹とm²²の数の組み合わせは、一般式(K-II)で表される金属錯体が中性錯体となる数の組み合わせが好ましい。

【0111】本発明のオルトメタル化金属錯体は一般式 (K-1)の繰り返し単位を一つ以上有する低分子化合物であっても良く、また、一般式 (K-1)の繰り返し単位を側鎖又は主鎖に複数個有するいわゆる、オリゴマー化合物やポリマー化合物(平均分子量 (Mw: ポリスチレン換算)は好ましくは $1000\sim 5000000$ 、より好ましくは $2000\sim 1000000$ 、さらに好ましくは $3000\sim 100000$ である。)であっても良い。本発明で用いるオルトメタル化金属錯体は低分子化合物が好ましい。

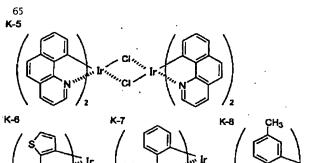
【0112】次に本発明に用いるオルトメタル化金属錯体の化合物例を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

[0113] [化44]



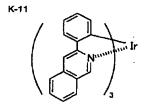
[0114]

【化45】



*

* [0116] 【化47】



[0117]

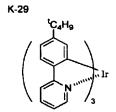
【化48】

[0119]

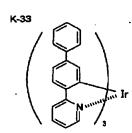
【0120】 【化51】

30

40



[0121]



*【化52】

K-35

K-36

[0122] [化53]

K-37

71 **K-38**

K-41

K-42

K-42

K-43

$$F$$
 H_3C
 H_3C

【0124】本発明で用いるオルトメタル化錯体は Inorg.Chem. 1991年, 30号, 1685頁.,同 1988年, 27号, 3 464頁.,同 1994年, 33号, 545頁. Inorg.Chim.Acta 19 91年, 181号, 245頁. J.Organomet.Chem. 1987年, 335号, 293頁.J.Am.Chem.Soc.1985年, 107号, 1431頁.等、種々の公知の手法で合成することができる。

【0126】本発明の化合物を発光素子用材料として用いた場合、ホール注入・輸送層、電子注入・輸送層、発光層のいずれに用いてもよいが、電子注入・輸送層および/または発光層として用いることが好ましい。また、本発明の化合物はT,レベルが大きいことから骨色発光

材料を含有する層に用いることが好ましい。

【0127】本発明の発光素子は陽極、陰極の一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄膜を形成した素子であり、発光層のほか正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有してもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えたものであってもよい。各層の形成にはそれぞれ種々の材料を用いることができる。

【0128】陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層などに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを用いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の材料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウムスズ(ITO)等の導電性金属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物50買、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど

の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、 特に、生産性、高導電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である が、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、よ り好ましくは $50nm\sim1\mu m$ であり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0129】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機 械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガ ラスを用いる場合には、通常0.2mm以上、好ましく は0.7mm以上のものを用いる。陽極の作製には材料 によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場 合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着 法、化学反応法(ゾルーゲル法など)、酸化インジウム 20 スズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極は 洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げたり、 発光効率を高めることも可能である。例えばITOの場 合、UV-オゾン処理、プラズマ処理などが効果的であ

【0130】陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層な どに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送 層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン 化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の 材料としては金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合 30 タリング、分子積層法、コーティング法(スピンコート 物、またはこれらの混合物を用いることができ、具体例 としてはアルカリ金属(例えばLi、Na、K、Cs 等) またはそのフッ化物、酸化物、アルカリ土類金属 (例えばMg、Ca等)またはそのフッ化物、酸化物、 金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金 またはそれらの混合金属、リチウム-アルミニウム合金 またはそれらの混合金属、マグネシウムー銀合金または それらの混合金属、インジウム、イッテリビウム等の希 土類金属等が挙げられ、好ましくは仕事関数が4 e V 以 下の材料であり、より好ましくはアルミニウム、リチウ ムーアルミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネ シウム-銀合金またはそれらの混合金属等である。陰極 の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通常10 n m~5μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 Onm~1μmであり、更に好ましくは100nm~1 μmである。陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリ ング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が 用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を 同時に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同

たあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。陽極及 び陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百Ω/□以 下が好ましい。

【0131】発光層の材料は、電界印加時に陽極または 正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができ ると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を 注入することができる機能や、注入された電荷を移動さ せる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ る機能を有する層を形成することができるものであれば 10 何でもよい。発光層に用いる化合物としては本発明の化 合物のほか、例えばベンゾオキサゾール、ベンゾイミダ ゾール、ベンゾチアゾール、スチリルベンゼン、ポリフ ェニル、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタジ エン、ナフタルイミド、クマリン、ペリレン、ペリノ ン、オキサジアゾール、アルダジン、ピラリジン、シク ロペンタジエン、ビススチリルアントラセン、キナクリ ドン、ピロロピリジン、チアジアゾロピリジン、シクロ ベンタジエン、スチリルアミンおよびそれらの誘導体、 芳香族ジメチリディン化合物、8-キノリノール誘導体 の金属錯体、遷移金属錯体(例えば、トリス(2ーフェ ニルピリジン) イリジウム (III)などのオルソメタル化 錯体等)や希土類錯体に代表される各種金属錯体等、ポ リチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレ ン、ポリフルオレン等のポリマー化合物等が挙げられ る。発光層の膜厚は特に限定されるものではないが、通 常lnm~5μmの範囲のものが好ましく、より好まし くは5 n m~1 μ m であり、更に好ましくは 1 0 n m~ 500nmである。発光層の形成方法は、特に限定され るものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッ 法、キャスト法、ディップコート法など)、インクジェ ット法、印刷法、LB法および転写法などの方法が用い られ、好ましくは抵抗加熱蒸着、コーティング法であ

【0132】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極か ら正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から 注入された電子を障壁する機能のいずれかを有している ものであればよい。その具体例としては、カルバゾー ル、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、 イミダゾール、ポリアリールアルカン、ピラゾリン、ピ ラゾロン、フェニレンジアミン、アリールアミン、アミ ノ置換カルコン、スチリルアントラセン、フルオレノ ン、ヒドラゾン、スチルベン、シラザンおよびそれらの 誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化 合物、芳香族ジメチリディン系化合物、ポリフィリン系 化合物、ポリシラン系化合物、ポリ(N-ビニルカルバ ゾール) 誘導体、アニリン系共重合体、チオフェンオリ ゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子オリゴマー等 が挙げられる。正孔注入層、正孔輸送層の膜厚は特に限 時に蒸着して合金電極を形成することも可能であり、ま 50 定されるものではないが、通常 1 n m ~ 5 µ m の範囲の ものが好ましく、より好ましくは $5nm\sim1\mu m$ であ り、更に好ましくは10nm~500nmである。正孔 注入層、正孔輸送層は上述した材料の1種または2種以 上からなる単層構造であってもよいし、同一組成または 異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。正 孔注入層、正孔輸送層の形成方法としては、真空蒸着法 やLB法、前記正孔注入輸送剤を溶媒に溶解または分散 させてコーティングする方法 (スピンコート法、キャス ト法、ディップコート法など)、インクジェット法、印 刷法および転写法などが用いられる。コーティング法の 10 場合、樹脂成分と共に溶解または分散することができ、 樹脂成分としては例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボ ネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポ リブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホ ン、ポリフェニレンオキシド、ポリブタジエン、ポリ (N-ビニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹 脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、 酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹 脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ 樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【0133】電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極か ら電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から 注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。好ましくは電子注入層及び/又は電子 輸送層に本発明の化合物を含有するものであるが、本発 明の化合物の他の材料を用いることもできる。その具体 例としては、トリアゾール、オキサゾール、オキサジア ゾール、フルオレノン、アントラキノジメタン、アント ロン、ジフェニルキノン、チオピランジオキシド、カル ボジイミド、フルオレニリデンメタン、ジスチリルピラ ジンおよびそれらの誘導体、ナフタレンペリレン等の複 素環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニンおよびそ れの誘導体、8-キノリノールおよびその誘導体の金属 錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベ ンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各 種金属錯体等が挙げられる。電子注入層、電子輸送層の 膜厚は特に限定されるものではないが、通常1nm~5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 nm~ 1 μ m で あり、 更 に 好 ま し く は 1 0 n m ~ 5 0 0 n m で ある。電子注入層、電子輸送層は上述した材料の1種ま たは2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一 組成または異種組成の複数層からなる多層構造であって もよい。電子注入層、電子輸送層の形成方法としては、 真空蒸着法やLB法、前記電子注入輸送剤を溶媒に溶解 または分散させてコーティングする方法(スピンコート 法、キャスト法、ディップコート法など)、 インクジェ ット法、印刷法、転写法などが用いられる。コーティン グ法の場合、樹脂成分と共に溶解または分散することが でき、樹脂成分としては例えば、正孔注入輸送層の場合 に例示したものが適用できる。

3

【0134】保護層の材料としては水分や酸素等の素子 劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能 を有しているものであればよい。その具体例としては、 In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, N i等の金属、MgO、SiO、SiO、、Al、O、、 GeO, NiO, CaO, BaO, Fe, O, Y,O, 、TiO, 等の金属酸化物、MgF, 、LiF、Al F,、CaF,等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリ プロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、 ポリウレア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロ トリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレ ン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロ エチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少な くとも1種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重 合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有 する含フッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、 吸水率0. 1%以下の防湿性物質等が挙げられる。保護 層の形成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸 着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、M 20 BE (分子線エピタキシ) 法、クラスターイオンビーム 法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(髙周波 励起イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レ ーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コ ーティング法、インクジェット法、印刷法および転写法 などを適用できる。

[0135]

50

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれにより限定されるものではない。 【0136】実施例1.洗浄した【T〇電極付きガラス 基板上に、銅フタロシアニンを膜厚5 n m、NPD (N, N'-ビス(1-ナフチル)-N, N'-ジフェニ ルベンジジン)を膜厚40nm、青色発光材料Aを膜厚 20 nm、表1記載の化合物を膜厚40 nmとなるよう にこの順に真空蒸着 (1.0 × 10⁻³ ∼ 1.3 × 10⁻³ P a) した。この上にパターニングしたマスク(発光面積 が4mm×5mmとなるマスク)を設置し、マグネシウ ム:銀=10:1を250nm共蒸着した後、銀300 nmを蒸着し(1.0×10-3~1.3×10-3Pa)、発 光素子を作製した。なお、作製した素子は乾燥グローブ ボックス内で封止した。東陽テクニカ製ソースメジャー ユニット2400型を用いて、ITOを陽極、Mg:A gを陰極として直流定電圧を発光素子に印加し発光さ せ、その輝度をトプコン社の輝度計BM-8、発光波 長、色度座標(CIE色度座標)を浜松フォトニクス社 製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて測定し た。また、作製した素子を85°C、70%RHの条件下 に3日間放置後発光させた相対輝度 (素子作製直後の輝 度を100とした場合の経時後の輝度を相対値で表した 値(駆動電圧10V))および発光面のダークスポット (未発光部)の有無を目視評価した。結果を表1に示

す。 【0127】 *【表1】

[0137]

表 1

79

解湖	化合物	発光波長	最高輝度	CIE色度座標	最低駆動	経時後の	ダークス	備考
No.		λ max(nm)	(cd/m²)	(X, Y)	電圧(V)	相対輝度	ポット発生	
101	比較化合物1	460	510	(0.15, 0.15)	6	79	無	比較例
102	比較化合物2	462	320	(0.15, 0.15)	7	19	有	比較例
103	比較化合物3	461	660	(0.15, 0.15)	6	12	有	比較例
104	比較化合物4	460	710	(0.15, 0.14)	6	17	有	比較例
105	例示化合物E-13	460	3426	(0.15,0.15)	4	90	無	本発明
106	例示化合物E-15	461	3821	(0.15,0.15)	4	95	無	本発明
107	例示化合物E-17	461	2962	(0.15,0.15)	4	88	無	本発明
108	例示化合物E-19	462	3311	(0.15,0.14)	4	93	無	本発明
109	例示化合物E-20	460	2781	(0.15,0.14)	4	88	無	本発明
110	例示化含物E-21	460	2659	(0.15,0.14)	4	83	無	本発明
111	例示化合物E-25	460	2415	(0.15,0.15)	4	80	無	本発明
112	例示化合物E-46	460	2555	(0.15,0.14)	4	87	無	本発明
113	例示化合物E-53	460	4100	(0.15,0.14)	4	96	無	本発明
114	比較化合物5	461	810	(0.15,0.15)	6	41	無	比較例
115	比較化合物6	461	630	(0.15,0.14)	6	30	無	比較例

[0138]

※ ※ 【化55】

特闘2000-63818 号記載の化合物

[0139] [化56]

青色発光材料 A

【0140】表1の結果より、本発明の化合物を用いる 容真空(株)製)を透明支持基板とした。この透明支持と非ドープ型の素子で電子輸送材として機能し、高輝度 50 基板をエッチング、洗浄後、銅フタロシアニンを約10

で色純度良好な青色発光が可能であることがわかる。また、高温保管後の輝度低下、ダークスポットの発生も少なく耐久性に優れていることがわかる。比較化合物5 および6の結果での比較から、最高輝度、低電圧駆動、耐久性においてその効果が顕著であることがわかる。

【0141】実施例2

洗浄した25mm×25mm×0.7mmのガラス基板上にITOを150nmの厚さで製膜したもの(東京三容真空(株)製)を透明支持基板とした。この透明支持基板をエッチング、洗浄後、銅フタロシアニンを約10

n m蒸着した。次にTPD(N,N' -ピス(3-メチルフェニル)-N,N'-ジフェニルベンジジン)約40n m、表2記載の発光層を約20n m、バソクプロインを約6n m、Alg(トリス(8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウム)約20n mを順に10-3~10-4 P a の真空中で、基板温度室温の条件下蒸着した。有機薄膜上にバターニングしたマスク(発光面積が5 m m×4 m m となるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=1

* し、EL素子を作製した。東陽テクニカ製ソースメジャーユニット2400型を用いて、直流定電圧をEL素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計BM-8、また発光波長については浜松ホトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて測定した。その結果を表2に示す。

[0142]

【表2】

0:1を250nm共蒸着した後、銀300nmを蒸着*

塞り		

				素子作成直後の日上神性	85°C保存数			
素子No.	発光をなられば	発光唇発光材料	発光 λ max	印加電圧 12/での輝度	外部量子效率	印加爾圧 12/での輝度	党光面比	備考
			(nm)	(cd/m²)	(%)	(od/m²)		
201	CBP	K-1	513	36600	8.1	11700	×	比較例
202	CBP	K-2	488	8200	6.4	3000	×	比较例
203	CBP	K-30	468	8	1.8	800	×	比較例
204	例示化合物 E-15	K-1	513	43700	10.5	32300	0	本部明
205	例示化合物 E-15	K-2	488	9100	7.7	7200	0	本発明
206	例示化合物 E-15	K-30	468	10400	4.6	8400	0	本部朔
207	例示化合物 E-10	K-1	514	37800	8.7	30200	0	本部別
208	例示化合物 E-10	K-2	489	8400	7.5	5800	0	本部明
209	例示化合物 E-28	K-1	513	41900	9.9	30000	0	本発明
210	例示化合物 E-28	K-2	488	9400	7.8	7000	0	本発明
211	例示化合物 E-28	K-30	466	8400	42	7100	0	本部明
212	例示化合物 E-11	K-1	514	37200	8.6	27600	0	本発明
213	例示化合物 E-11	K-2	487	8600	72	7100	0	本角明
214	例示化合物 E-16	K-1	512	39000	92	30600	0	本発明
215	例示化合物 E-16	K-2	489	9100	7.4	7100	0	本発明

* 〇:ダークスポット(未発光部)発生小、×:ダークスポット発生大

[0143]

※ ※【表3】

表2 (つづき)

				素子作成直接のEL特性		85°C 保存後 E		
奈于No.	発光圏ホスト材料	発光局発光材料	発光λmax	印加加王 12/での輝度	外部量子効率	印加電圧 12/での輝度	免光面以	備考
			(nm)	(cd/m²)	(%)	(cd/m²)		
216	例示化合物 E-18	K-1	514	38000	8.7	28900	0	本勢明
217	例示化合物 E-18	K-2	488	8700	7.1	6800	0	本発明
218	例示化合物 E-45	K-1	513	37600	8.4	28200	0	本部朔
219	例示化合物 E-45	K-2	488	8500	8.1	6500	0	本発明
220	例示化合物 E-45	K-30	467	7200	3.6	5600	0	本発明
221	例示化合物 E-53	K-1	514	44800	10.6	34200	0	本発明
222	例示化合物 E-53	K-2	489	9800	8.8	8100	0	本発明
223	例示化含物 E53	K-30	468	11200	6.8	7800	0	本部明
224	比較化合物-5	K-1	513	28000	5.9	14000	×	比較明
225	比較化合物5	K-2	489	8600	6.9	4300	0	比较到
226	比較化合物6	K-30	469	6700	27	1800	×	比較例
227	比較化合物6	K-1	514	25400	5.1	12100	×	比较列
228	比較化合物-6	K-2	489	8400	6.7	4000	0	比較列
229	比較化合物一6	K-30	470	5500	22	1400	×	比较列

[0144] [化57]

比較化合物-5

83

比較化合物-6

【0145】 【化58】 CBP

Applied Physics Letters, 754(1989) 記載の化合物

【0146】また、これらの素子をアルゴンガスで置換したオートクレーブ中に封入し、85℃の加熱条件下3日間保存した後に、同様の輝度測定・および発光面状観察を行った結果も表2に示す。

【0147】表2の結果から、文献化合物であるCBPを用いた素子では髙温保存した後に大幅な輝度低下およびダークスポット(未発光部)の発生が多く見られるのに対し、本発明の化合物を用いた素子では、輝度の低下も少なく、素子の発光面状も良好で、素子の保存耐久性が大幅に向上していることがわかる。比較化合物5、6との比較において、本発明の化合物は連結基しを有する事により、輝度、量子効率、耐久性において優れている。

10 【0148】実施例3

実施例2と同様にエッチング、洗浄したITOガラス基 板上に、ポリ (N-ビニルカルバゾール(PVK)) 40m g、2-(4-tert-ブチルフェニル)-5-(4-ビフェニルイ ル)-1,3,4-オキサジアゾール(PBD)12mg、K-1 lmgを1,2-ジクロロエタン3mlに溶解した溶液をス ピンコートした。このときの有機層の膜厚は約120 n mであった。次いで実施例2と同様に陰極を蒸着し、E L素子301を作製した。素子301に対して、K-1 の代わりに表3に示した化合物(ホスト材料:20m 20 g, 発光材料: 1 mg) を添加した以外は、301と全 く同じ組成のEL素子302~322を作製した。東陽 テクニカ製ソースメジャーユニット2400型を用い て、直流定電圧をEL素子に印加し発光させ、その輝度を トプコン社の輝度計BM-8、また発光波長については 浜松ホトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-1 1を用いて測定した。その結果を表3に示す。

[0149]

【表4】

85	

	章 作	比较密	比数例	比較例	比較倒	本祭明	本無明	本然明	本統明	本统图	本物理	本発明	本発明	本免明	本発明	本発明	本免明	本発明	本発明	比較例	比较例	九数包	比数包
85℃保存後日 特性	免光面状*	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×
85℃保	印加電圧18Vでの 輝度(cd/m²)	3200	2100	2800	1600	11200	11100	13300	11600	0088	12600	12900	11900	11800	12700	11200	7900	13600	10800	6400	4900	5400	4400
世	外部量子効率 (%)	2.6	2	2.9	2.3	3.8	4.1	4.4	4.7	3.1	1.4	4.5	4.0	3.8	4.7	4.0	3.4	5.0	3.8	2.7	2.6	2.4	2.5
報子作成画後のEL特性	印加電圧18Vでの輝度 (cd/m²)	11200	8400	12300	0096	15200	16000	16700	17200	12200	15300	18400	15500	14600	18100	13800	11400	17800	13100	12600	10400	11400	9800
	発光入max (nm)	514	488	513	488	513	514	514	514	486	513	513	513	513	514	513	488	214	487	512	987	513	489
	先光材料	K-1	K-2	K-1	K-2	K-1	K-1	K-1	¥-1	K-2	K-1	K-1	K-1	K-1	¥-1	K-1	K-2	K-1	K-2	¥-1	K-2	K-1	K-2
	ホスト材料	-	1	CBP	CBP	何示化合物E-9	61 示化合物E-13	例示化合物E-16	例示化合物E-15	例示化合物E-15	例示化合物E-17	例示化合物E-18	例示化合物E-24	例示化合物E-27	例示化合物E-28	例示化合物E-45	例示化合物E-45	例示化合物E-53	例示化合物E-53	比較化合物一5	比較化合物—5	比較化合物-6	比較化合物一8
	₩ è	ä	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322

[0150]

₩3

【化59】

量量平均分子量 23000 (ポリステレン換算)

クマリン6

【0151】表3の結果から明らかな様に、本発明の素 子では通常発光効率が低い塗布型素子においても高い発 光輝度、発光効率を示し、また、保存耐久性に関しても 優れていることがわかる。

【0152】実施例4

洗浄した25mm×25mm×0.7mmのガラス基板 上に I T O を 1 5 0 n m の 厚さで 製膜 したもの (東京三 容真空(株)製)を透明支持基板として用い、これをエ ッチング、洗浄したのち、テトラキス(4-ジフェニル 30 定および評価を行なった。結果を表4に示す。 アミノフェニル) シラン約50nm、下記表4に記載の ホスト材料および発光材料からなる発光層約36 nm、*

*下記化合物(15)約36nmをこの順に10-3~10 - 1 Paの真空中、室温下で蒸着した。得られた有機薄膜 上に発光面積が5mm×4mmとなるようにパターニン グしたマスクを設置し、蒸着装置内でマグネシウムおよ び銀(マグネシウム:銀=10:1)を250nm共蒸 着した後、更に銀300nmを蒸着して、下記表4に示 す発光素子401~409を作製した。

【0153】得られた各発光素子に実施例2と同様の測

[0154]

【表5】

未子			発光波長	素子作成直後の	発光特性	85℃保存後の5	绝光特性	
No.	ホスト材料	発光材料	λ max (nm)	印加電圧 12V で の輝度(cd/m²)	外部量子 効率(%)	印加電圧 12V で の輝度 (cd/m²)	発光面状	備考
401	CBP	K-48	465	216	0.9	32	×	比較例
402	例示化合物 E-13	K-48	464	4400	6.9	3700	0	本発明
403	例示化合物 E-15	K-48	464	4600	6.6	3600	0	"
404	例示化合物 E-17	K-48	463	4100	5.7	3400	0	"
405	例示化合物 E-18	K-48	463	3900	5.1	3100	0	"
406	例示化合物 E-45	K-48	484	3600	4.7	2900	0	"
407	例示化合物 E-53	K-48	484	5200	7.8	4300	0	"
408	比較化合物-5	K-48	465	960	1.2	340	×	比較例
409	比較化合物-6	K-48	465	740	1.1	270	×	"

【0155】表4の結果から、ホスト材料としてCBP を用いた比較用の素子401、408、409では作成 直後の輝度および外部量子効率が低く、高温保存した後 に大幅な輝度低下およびダークスポットの発生が見られ るのに対し、本発明の発光素子用材料を用いた素子40 2~407では作成直後の輝度および外部量子効率が良 好であり、また髙温保存した後の輝度低下は少なく、発 50 光面状も良好であり、作成直後の発光特性と保存耐久性 がともに優れていることがわかる。

[0156]

【化60】

(比合物(15) CH₃

N

N

CH₃

N

CH₃

N

CH₃

[0157]

光輝度、発光効率を示し、また保存耐久性に関しては、高温保存した後に輝度低下も少なく、かつ発光面状も良好で、素子の保存耐久性が大幅に改良される。また、通常発光効率が低い塗布型素子においても上記と同様な効果が得られる。さらに[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン骨格または[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a]ピリミジン骨格を分子内に2つ以上有する化合物を含有する事により、本発明の課題を達成で

* 荷輸送材料として用いたいずれの場合も、素子は高い発

10 きることが分かる。

【発明の効果】本発明の化合物をホスト材料あるいは電*

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C07F 15/00		CO7F 15/00	F
C 0 8 K 5/00		C 0 8 K 5/00	
C08L 101/00		C08L 101/00	
C09K 11/06		C09K 11/06	
	6 4 0		6 4 0
	660		660
H 0 5 B 33/14		H O 5 B 33/14	В
33/22		33/22	В
			D

F ターム (参考) 3K007 AB00 AB02 AB03 AB04 AB06
AB13 BB05 CA01 CA05 CB01
DA00 DB03 EB00 FA01 FA02
4C050 AA01 BB06 CC08 EE04 FF02
FF05 FF10 GG01 GG03 HH03
HH04
4C072 MM02 UU05
4H050 AA01 AB92 WB11 WB13 WB14
4J002 BC102 BE042 BJ002 EU156
EU186 EU216 EV086 EV306
EV316 EX086 FD202 FD206
GC00 GF00 GL00 GP00 GQ00

GS00